## Резюме проекта, выполняемого в рамках ФЦП

### «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»

по этапу №3

Номер Соглашения о предоставлении субсидии: 14.604.21.0089

<u>Тема:</u> ««Мощные фотоэлектрические преобразователи лазерного излучения с КПД более 60% для систем лучевой энергетики»

Приоритетное направление: Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

<u>Критическая технология:</u> Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии

Период выполнения: 27.06.2014 - 31.12.2016

Плановое финансирование проекта: 31.50 млн. руб.

Бюджетные средства 25.00 млн. руб., Внебюджетные средства 6.50 млн. руб.

<u>Получатель:</u> Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

<u>Индустриальный партнер</u> Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева"

<u>Ключевые слова:</u> Эпитаксиальное выращивание, фотоэлектрическое преобразование энергии, КПД, гетероструктуры, технология, лазерное излучение

### 1. Цель проекта

Проект направлен на разработку технических средств для создания перспективных источников энергии на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) лазерного излучения.

Основной целью проекта является разработка и создание высокоэффективных мощных (до  $500~\rm BT/cm2$ ) фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения на основе A3B5 с КПД  $\sim 50$  - 60% при преобразовании лазерного излучения в диапазоне длин волн  $0.78-1.68~\rm mkm$ .

#### 2. Основные результаты проекта

В ходе выполнения этапа №3 получены следующие основные научно-исследовательские результаты:

- Эскизная конструкторская документация и экспериментальная установка для исследовательских испытаний изготовленных макетов ФЭП лазерного излучения с длинами волн  $\lambda$ =809 нм и  $\lambda$ =1064 нм (размер ФЭП 2x2 см) с КПД >50% и с  $\lambda$ =1064 нм (1x1 см) с КПД > 35%.
- Программа и методики исследовательских испытаний макетов ФЭП лазерного излучения.
- Программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов модулей ФЭП лазерного излучения.

В результате проведённых исследований и испытаний было установлено следующее:

- Определены закономерности изменения скоростей осаждения соединений GaAs и AlAs в зависимости от температуры и потока атомов элементов III группы. Разработана технология получения макетов  $\Phi$ ЭП лазерного излучения (ЛИ) для длины волны  $\lambda$ =809 нм.
- Исследованы особенности роста бинарного соединения InAs и твердых растворов  $In_xGa_{1-x}As$  методом газофазной эпитаксии. Определены зависимости скорости осаждения слоев InAs для температур 480-700 °C. Разработана технология структур AlInGaAs/InGaAs, получены ФЭП ЛИ размером 1 см х 1 см. Монохроматический КПД макета ФЭП ЛИ ( $\lambda$ =1064 нм) составил 36.0% при мощности лазера 1.0 Вт.

- Предложены варианты оптимизации технологии получения фотоэлементных структур GaInAsP/InP с засветкой со стороны подложки и со стороны твердого раствора.
- Для ФЭП ЛИ на основе AlGaAs/GaAs (809 нм) площадью 4 см<sup>2</sup> достигнута эффективность преобразования  $\eta = 53.5\%$ . Для малоразмерных ФЭП ЛИ эффективность возрастала до 56.0%.

Результаты научно-технической деятельности, полученные в процессе выполнения этапа № 3, были представлены в виде доклада на международной конференции в Гамбурге (Германия), а также в 3-х публикациях в журналах, индексируемых в базе данных Scopus и в Web of Science.

Полученные результаты соответствуют требованиям технического задания проекта.

Научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения этапа, являются новыми и находятся на уровне мировых достижений. Предполагаемые научно-технические решения соответствуют научно-техническому уровню, ожидаемому после 2015 года.

# 3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки

Изобретение заявка №2015146252 от 27.10.2015 "Способ изготовления фотоэлемента на основе GaAs", РФ

### 4. Назначение и область применения результатов проекта

Полученные результаты предназначены для создания фотоэлектрических панелей на основе разрабатываемых ФЭП лазерного излучения как для космического, так и для наземного применения. Для наземного использования систем беспроводной передачи энергии перспективными являются фотопреобразователи лазерного излучения для длин волн 0.78 -0.84 мкм (основе AlGaAs/GaAs структур) для преобразования лазерного излучения, передаваемого в том числе по оптоволокну.

Физико-математические модели для описания процессов преобразования потоков мощного лазерного излучения в ФЭП, полученные на основании расчета полупроводниковых структур и конструкций ФЭП, обеспечивающих высокоэффективное преобразование лазерного излучения с заданной длиной волны, а также разрабатываемая технология выращивания гетероструктур ФЭП методом МОС-гидридной эпитаксии, могут быть использованы для получения ФЭП лазерного излучения, которые необходимы, в частности, как составной элемент системы передачи энергии по лазерному лучу с борта на борт космических спутников, в которых отсутствует возможность применения солнечных батарей для получения электроэнергии.

### 5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Ожидаемые социально-экономические эффекты от использования товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов заключаются в повышении производительности труда, а также снижении материало- и энергоёмкости производства.

### 6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Проектом предусмотрена коммерциализация — заключен Договор от 03.03.2014 г. с Индустриальным партнером Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва» (ОАО "РКК "Энергия") о дальнейшем использовании результатов ПНИ.

### 7. Наличие соисполнителей

Соисполнители не привлекались для выполнения работ по проекту.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Зам. директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе

Руководитель работ по проекту

С.В. Лебедев

В.П. Хвостиков